
2SC2979

シリコン NPN 三重拡散形

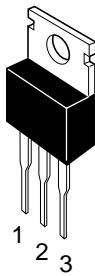
HITACHI

特長

- 高電圧高速度大電力スイッチング用

外観図

TO-220AB



1. Base
2. Collector
(Flange)
3. Emitter

絶対最大定格

(Ta = 25)

項目	記号	2SC2979	単位
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	900	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	800	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	7	V
コレクタ電流	I_C	3	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(peak)}$	6	A
ベース電流	I_B	1.5	A
許容コレクタ損失	P_C^{*1}	40	W
接合部温度	T_J	150	
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	

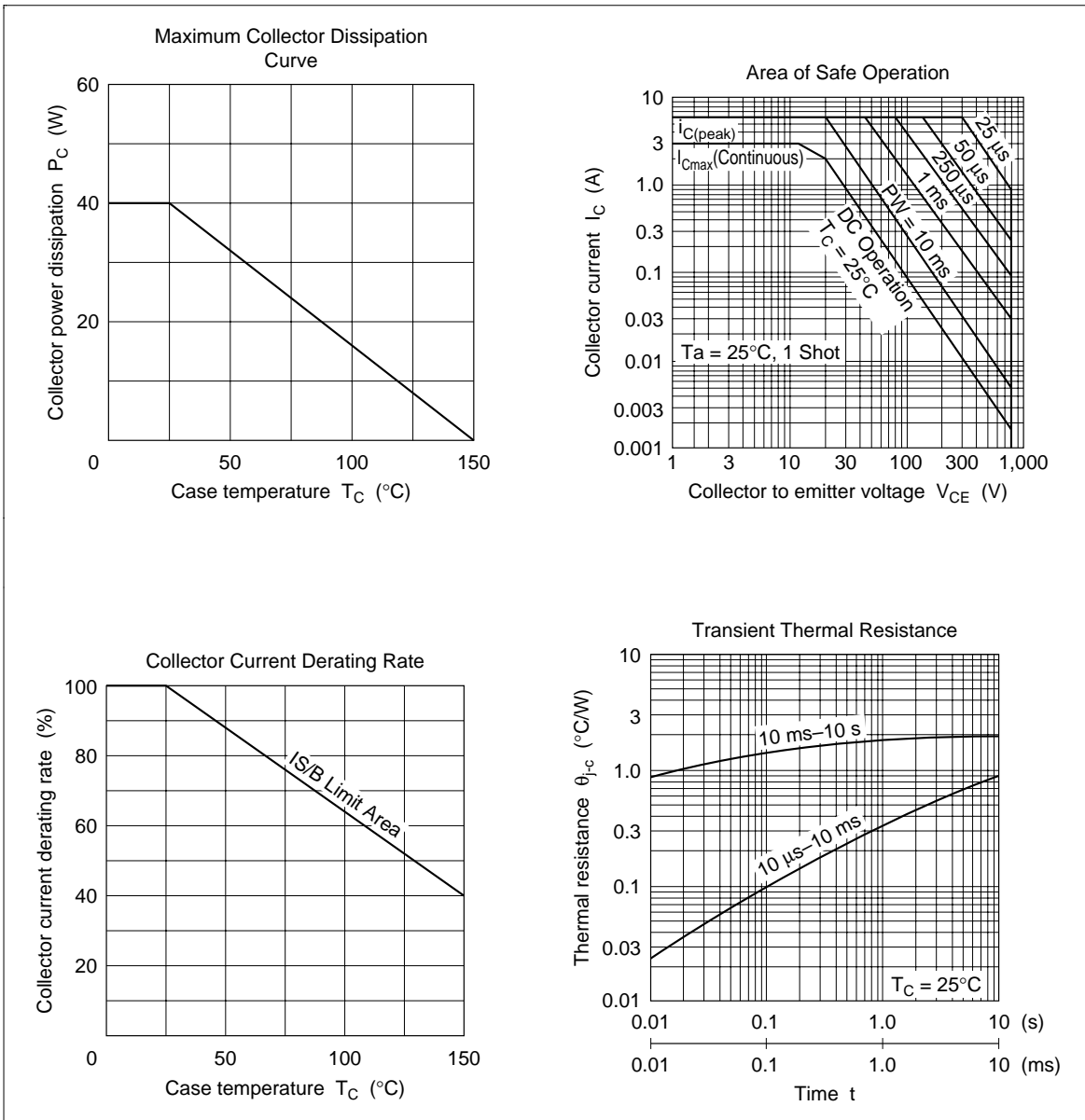
【注】 1. $T_C = 25$ における許容値

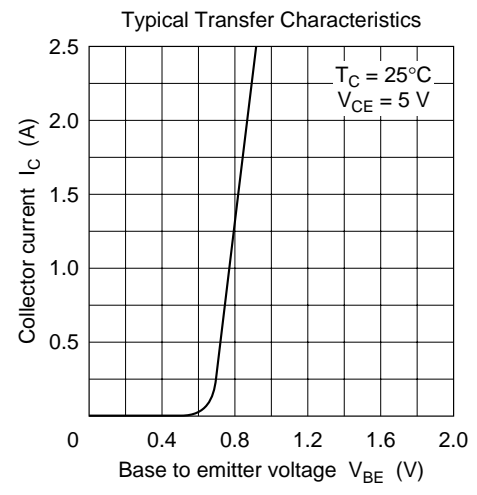
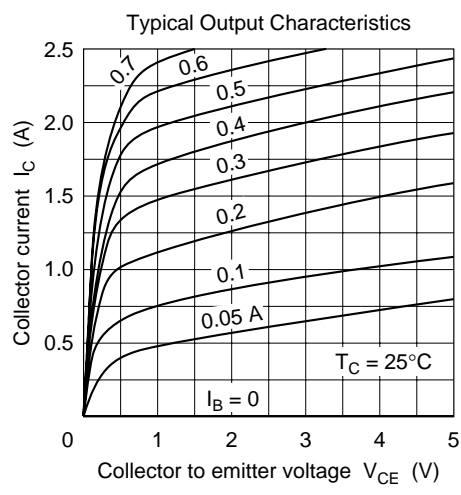
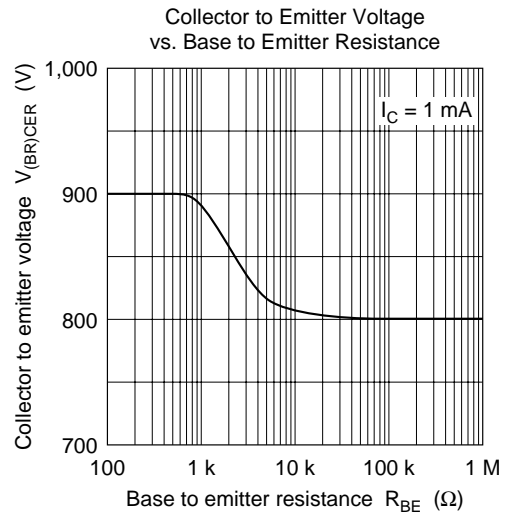
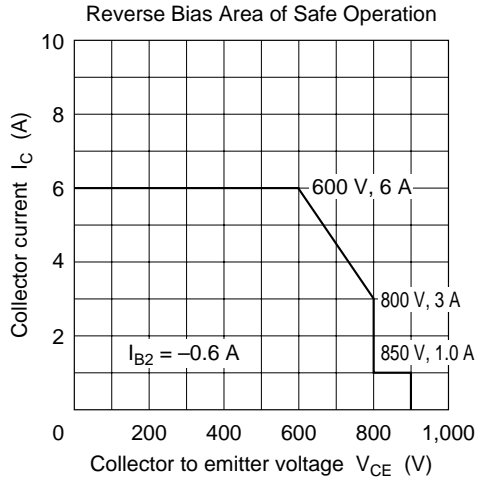
電気的特性

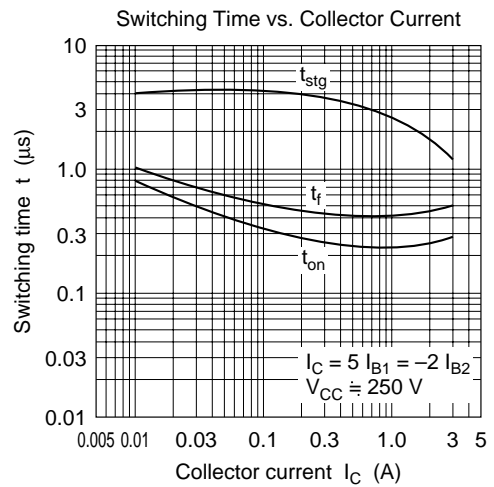
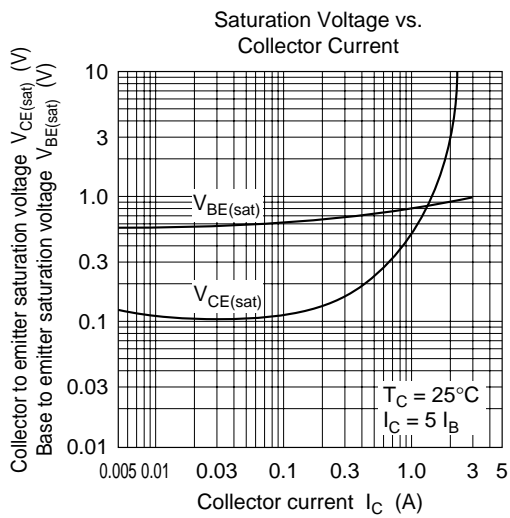
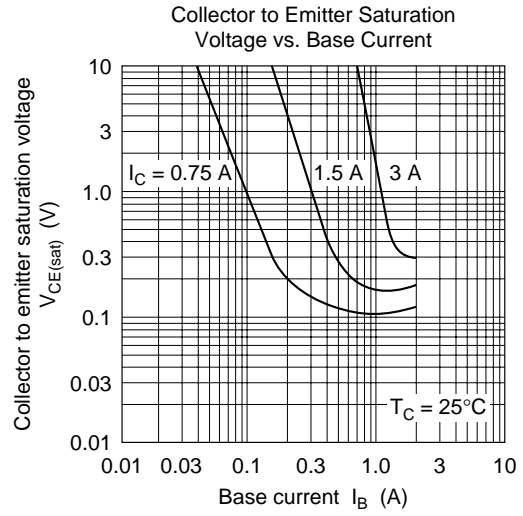
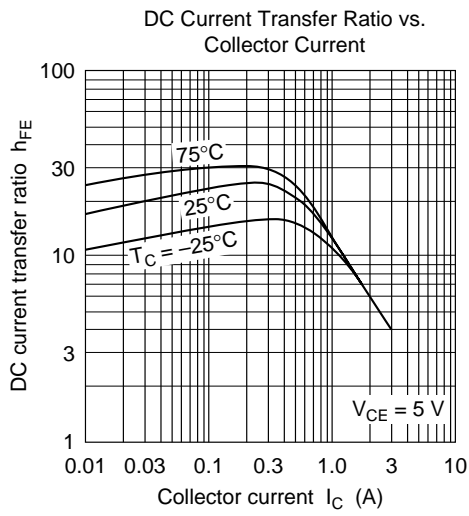
(Ta = 25)

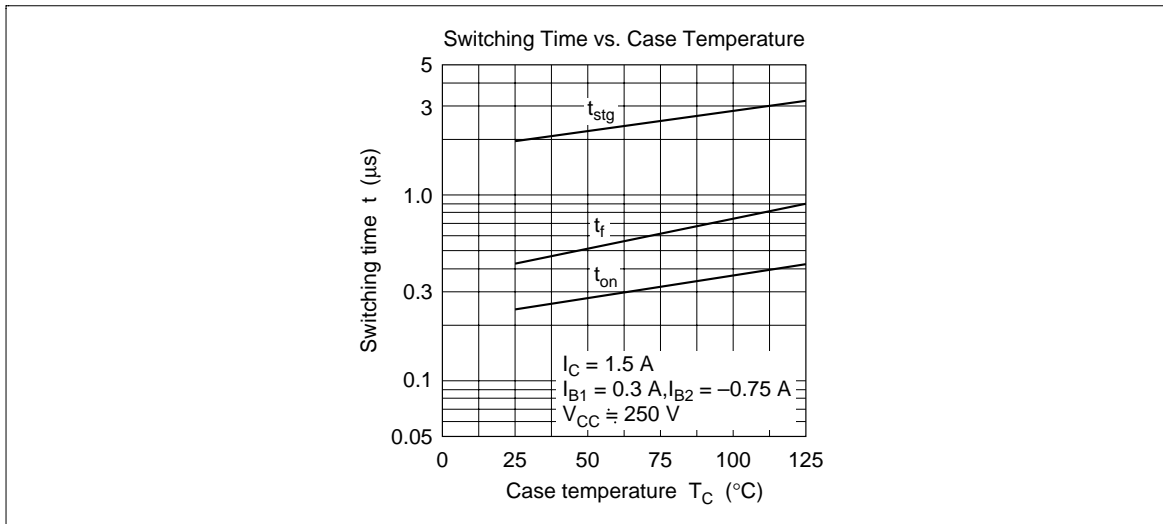
項目	記号	Min	Typ	Max	単位	測定条件
コレクタ・エミッタ維持電圧	$V_{CEO(sus)}$	800	—	—	V	$I_C = 0.2A, R_{BE} = , L = 100mH$
コレクタ・エミッタ維持電圧	$V_{CEX(sus)}$	800	—	—	V	$I_C = 3A, I_{B1} = 0.9A, I_{B2} = -0.6A, R_{BE} = -5.0V, L = 180\mu H, Clamped$
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	7	—	—	V	$I_E = 10mA, I_C = 0$
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	—	—	100	μA	$V_{CB} = 750V, I_E = 0$
コレクタ遮断電流	I_{CEO}	—	—	100	μA	$V_{CE} = 650V, R_{BE} =$
直流電流増幅率	h_{FE1}	15	—	—		$V_{CE} = 5V, I_C = 0.3A^{*1}$
直流電流増幅率	h_{FE2}	7	—	—		$V_{CE} = 5V, I_C = 1.5A^{*1}$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	—	1.0	V	$I_C = 0.75A, I_B = 0.15A^{*1}$
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	—	—	1.5	V	$I_C = 0.75A, I_B = 0.15A^{*1}$
ターンオン時間	t_{on}	—	—	1.0	μs	$I_C = 1.5A, I_{B1} = 0.3A, I_{B2} = -0.75A,$
蓄積時間	t_{stg}	—	—	3.0	μs	$V_{CC} = 250V$
下降時間	t_f	—	—	1.0	μs	

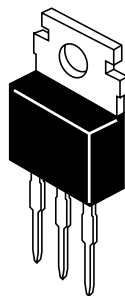
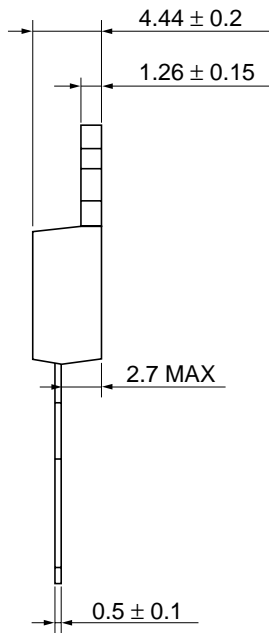
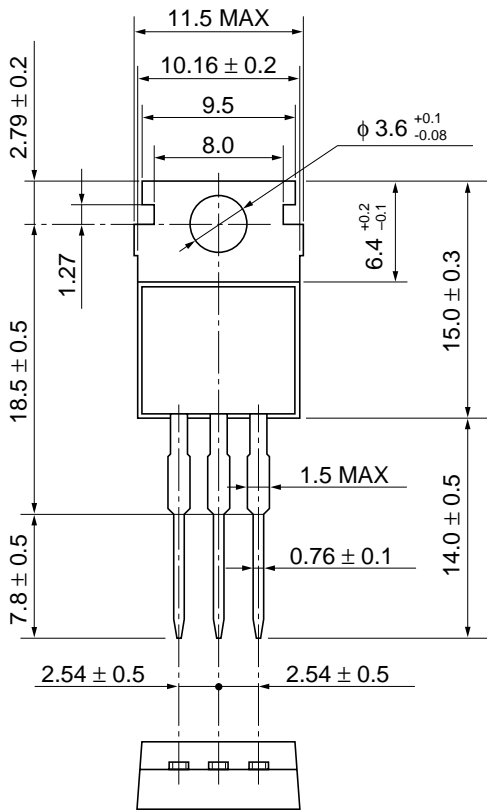
【注】 1. パルス測定











Hitachi Code	TO-220AB
JEDEC	Conforms
EIAJ	Conforms
Weight (reference value)	1.8 g